

NEW

SSM6L61NU

Small-signal MOSFET 2 in 1

Description

Polarity	N-ch + P-ch	
Internal Connection	Independent	
Component Product (Q1)	SSM6N61NU	
Component Product (Q2)	SSM6P49NU	
AEC-Q101	Conform(*)	*: For detail information, please contact to our sales.
RoHS Compatible Product(s) (#)	Available	
Assembly bases	Thailand	

Properties

Package Information

Package Image	
Toshiba Package Name	UDFN6
Pins	6
Mounting	Surface Mount

Absolute Maximum Ratings

Characteristics	Symbol	Rating	Unit
Drain current (Q1)	I_D	4	A
Drain current (Q2)	I_D	-4	A
Drain-Source voltage (Q1)	V_{DS}	20	V
Drain-Source voltage (Q2)	V_{DS}	-20	V
Gate-Source voltage (Q1)	V_{GS}	+/-8	V
Gate-Source voltage (Q2)	V_{GS}	+/-12	V

Electrical Characteristics

Characteristics	Symbol	Condition	Value	Unit
Drain-Source on-resistance (Q1) (Max)	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=2.5V$	0.047	Ω
Drain-Source on-resistance (Q1) (Max)	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=1.5V$	0.105	Ω
Drain-Source on-resistance (Q1) (Max)	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=1.8V$	0.067	Ω
Drain-Source on-resistance (Q1) (Max)	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=4.5V$	0.038	Ω
Drain-Source on-resistance (Q1) (Typ.)	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=2.5V$	0.036	Ω
Drain-Source on-resistance (Q1) (Typ.)	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=1.5V$	0.056	Ω
Drain-Source on-resistance (Q1) (Typ.)	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=1.8V$	0.047	Ω
Drain-Source on-resistance (Q1) (Typ.)	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=4.5V$	0.029	Ω
Drain-Source on-resistance (Q2) (Max)	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=-2.5V$	0.076	Ω
	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=-1.8V$	0.157	Ω

Drain-Source on-resistance (Q2) (Max)				
Drain-Source on-resistance (Q2) (Max)	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=-10V$	0.045	Ω
Drain-Source on-resistance (Q2) (Max)	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=-4.5V$	0.056	Ω
Drain-Source on-resistance (Q2) (Typ.)	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=-2.5V$	0.06	Ω
Drain-Source on-resistance (Q2) (Typ.)	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=-1.8V$	0.083	Ω
Drain-Source on-resistance (Q2) (Typ.)	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=-10V$	0.036	Ω
Drain-Source on-resistance (Q2) (Typ.)	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=-4.5V$	0.044	Ω
Gate threshold voltage (Q1) (Max)	V_{th}	-	1.0	V
Gate threshold voltage (Q1) (Min)	V_{th}	-	0.4	V
Gate threshold voltage (Q2) (Max)	V_{th}	-	-1.2	V
Gate threshold voltage (Q2) (Min)	V_{th}	-	-0.5	V

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9